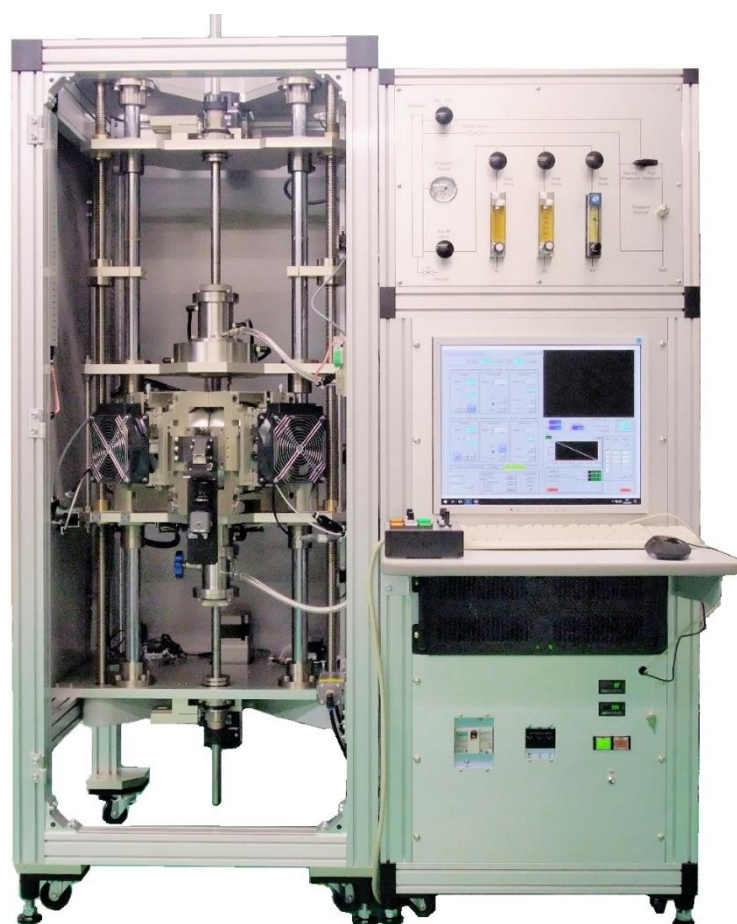


四楕円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式：FZ-T-4000-H-VIII-VPO-PC



Crystal Systems Corporation

株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL 0551-36-5271 FAX:0551-36-5273

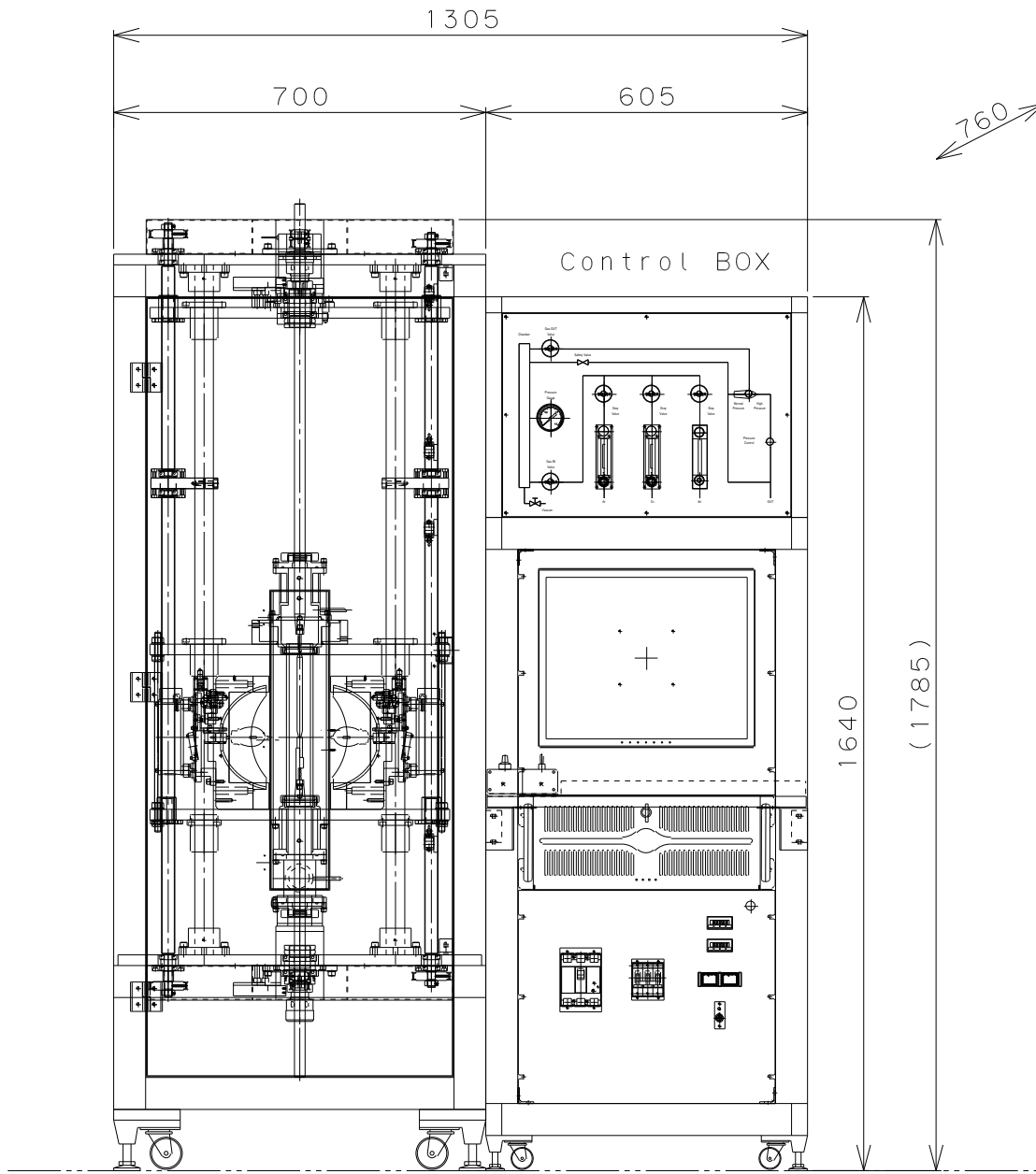
<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: eigyo@crystalsys.co.jp

1. 装置仕様書

型式		FZ-T-4000-H-VIII-VPO-PC	
使用ランプ種類		ハロゲン	
使用ランプ、ミラー個数		4 (個)	
最高到達圧力		0.95 (MPa)	
最高到達真空度		5×10^{-5} (Torr) (6.7×10^{-3} Pa)	
シャフト部シール方式		O リングシール	
最高到達温度		2,200 (°C)	
常用使用温度		1,850 (°C)	
標準具備ランプ (各ランプは 4 本一組、各 2 組を標準 装備)		300 (W)	
		1,000 (W)	
円周方向温度差		30 (°C以下)	
ランプ冷却方式		空冷	
ミラー冷却方式		空冷	
石英管シール冷却方式		水冷	
シャフト/ミラーステージ		上シャフト移動 / 下シャフト固定 / ミラーステージ移動	
ミラーステージ移動長(結晶育成長)		150 (mm)	
上シャフト移動長(原料棒供給長)		150 (mm)	
最大原料棒長		200 (mm)	
ミラーステージ(結晶育成) 移動速度遅送り		0.01~300 (mm/hr)	
ミラーステージ移動速度早送り		6~150 (mm/min)	
上シャフト移動速度遅送り		0.01~300 (mm/hr)	
上シャフト移動速度早送り		6~150 (mm/min)	
上下シャフト回転速度		5~100 (rpm)	
熔融域観察方式		CCD カメラ	
雰囲気ガス流量制御 (フロート式フローメーター)		①Ar 5 (L/min) ②O ₂ 500 (cc/min) ③Air 10 (L/min) (コンプレッサー付)	
制御方式	PC	LabVIEW (OS Windows10)	
	手動	手元操作 BOX	
ランプ出力制御方式		プログラム式出力調整 (4 本を一括制御)	
出力安定度		入力変動±10 (%)に対して±0.2 (%)以下	
用力	電力	三相 200 (V), 30 (A)	
	冷却水	3 (L/min)	
装置寸法 (mm)		本体	制御盤 (ガス BOX 含む)
	幅	700	605
	奥行	760	760
	高さ	1,785	1,640

注) 上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。

3. 参考図



単位：mm

4. 配置図

